

АРИСТОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ



Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор.

Дата и место рождения: 29 апреля 1945 года, город Рассказово.

В 1962 году оканчивает среднюю школу №6 г. Рассказово.

В 1968 году оканчивает МФТИ (Московский физико-технический институт).

С 1993 года - заведующий кафедрой «Физики и технологии микроэлектроники» факультета физической и квантовой электроники МФТИ.

С 30 мая 1997 года - член-корреспондент Российской академии наук по Отделению нанотехнологий и информационных технологий.

С 1991 по 2004 гг. - директор Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.

С 2005 - главный научный сотрудник Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН, председатель специализированного докторского совета ИПТМ РАН.

К наиболее важным результатам научной деятельности относятся результаты в области создания элементов рентгеновской оптики. Обосновано использование для изготовления рентгеновских линз совершенных кристаллов и многослойных зеркал, эти линзы, названные брэгг-френелевскими, являются аналогом синтезированных трехмерных рентгеновских голограмм. Создана их теория и разработана технология их изготовления. В настоящее время линзы используются как в России, так и за рубежом. ими оснащаются источники синхротронного излучения, такие как ESRF (Франция), BESSY (Германия), SPring-8 (Япония).

К важным научным результатам принадлежат работы в области создания методов микротомографии для исследования и диагностики микродефектов и микроструктур, создан ряд новых методов электронно-микроскопического исследования и контроля полупроводниковых кристаллов. Широкое практическое применение получила программа коррекции эффекта близости в электронно-лучевой литографии.

В последние годы проведены исследования в области квантовой механики, доказывающиеся необходимость изменения отношения к волновым функциям электронов как к функциям вероятности. Проведены и проанализированы эксперименты, связанные с эффектами рассеяния жёсткого излучения на электронах, прежде всего, с эффектом Комптона.

Доктор физико-математических наук, профессор.

Избирался членом президиума Всероссийского общественно-политического движения «Духовное наследие», Славянской академии наук; член Азиатско-Тихоокеанской академии материаловедения.

Инициатор возрождения в России детской патриотической организации - организации Российских юных разведчиков - скаутов (ОРИОР).

Правительственные награды: медаль «За трудовое отличие» (1975), ордена «Знак Почета» (1981), «Дружбы Народов» (1986), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1989). Лауреат Премии Ленинского комсомола (1979).

Организация: Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.

Адрес организации: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, 6, ИПТМ РАН.

Телефон: (496) 524-42-76.

E-mail: aristov@iptm.ru